EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

10209256

PUBLICATION DATE

07-08-98

APPLICATION DATE

22-01-97

APPLICATION NUMBER

09023192

APPLICANT:

TOMOEGAWA PAPER CO LTD;

INVENTOR:

MATSUNAGA TADAO;

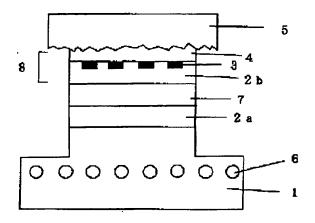
INT.CL.

H01L 21/68 H02N 13/00

TITLE

ELECTROSTATIC CHUCK DEVICE

AND ITS MANUFACTURE



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the thermal conductivity of an electrostatic chuck device and, at the same time, to improve the replaceability of an insulating film having an adsorbing surface, by laminating electrode layers and the insulating film on a ceramic insulating plate through adhesive layers.

SOLUTION: In an electrostatic chuck device, a first adhesive layer 2a having a high insulating property, a ceramic insulating plate 7, a second adhesive layer 2b, electrode layers 3 composed of vapor-deposited or plated metallic films, and an insulating film 4 are successively formed on a metallic substrate 1. The electrode layers 3 are provided so as to generate polarized charges on the adsorbing surface of the insulating film 4 and the adhesive layers 2a and 2b are formed of a thermosetting or thermoplastic adhesive, because the layers 2a and 2b must have strong adhesive forces and electrical characteristics against the insulating plate and metallic substrate comprising the insulating film 4, the electrode layers 3, and the ceramic insulating plate 7, and metallic substrate 1. Therefore, the thermal conductivity of the adhesive layers 2a and 2b can be improved as the thin film and, at the same time, the workability of the replacing work of the insulating film 4 can be improved when the film 4 is fatigued, because the thicknesses of the layers 2a and 2b are reduced.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-209256

(43)公開日 平成10年(1998)8月7日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

H01L 21/68

R

H 0 2 N 13/00

D

H 0 2 N 13/00

HO1L 21/68

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 6 頁)

(21)出願番号

特顯平9-23192

(71)出顧人 000153591

株式会社巴川製紙所

東京都中央区京橋1丁目5番15号

(22)出願日

平成9年(1997)1月22日

(72)発明者 松永 忠生

静岡県清水市入江1-3-6 株式会社巴

川製紙所電子材料事業部内

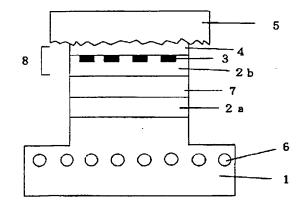
(54) 【発明の名称】 静電チャック装置およびその製造方法

(57)【要約】

(修正有)

【課題】従来の装置は被吸着面に電極による凹凸があ り、接着剤層によりそれを改良したものではその厚さに より熱伝導性が悪くなっていた。

【解決手段】金属基盤1上に第1の接着剤層2a、セラ ミックからなる絶縁板7、第2の接着剤層2b、金属の 蒸着膜またはメッキ膜からなる電極層3および絶縁性フ ィルム4を順次積層する構造とする。従来の各接着剤層 を薄層にできるため、熱伝導性を改善できると同時に、 絶縁性フィルムが疲労した場合の交換作業性が大幅に改 善できる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属基盤上に第1の接着剤層、セラミックからなる絶縁板、第2の接着剤層、金属の蒸着膜またはメッキ膜からなる電極層および絶縁性フィルムを順次積層してなることを特徴とする静電チャック装置。

【請求項2】 前記金属の蓋着膜またはメッキ膜からなる電極層が絶縁性フィルムの一面に形成されてなることを特徴とする請求項1記載の前電チャック装置。

【請求項3】 絶縁性フィルムの一面に、金属の蒸着膜またはメッキ膜からなる電極層を構成し、該電極層の表面にフォトレジスト層を設け、パターン落光を行い、現像し、エッチング処理を行う工程と、エッチング処理された電極層面に第2の接着削層を設けて積層体シートを作成する工程と、セラミックからなる絶縁板を第1の接着削層を介して金属基盤に接着する工程と、セラミックからなる絶縁板と該接着体シートとを第2の接着削層を介して接着する工程からなることを特徴とする静電チャック装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体集積回路製造装置等、ウエハ等の導電性物質を真空中で保持できる静電チャック装置に関し、特に吸着力、熱伝導性に優れ、吸着面(ウエハ接着面)を有する絶縁性フィルムの交換が容易な静電チャック装置およびその作製方法に関する。【0002】

【従来の技術】半導体ウエハを加工する工程において は、半導体ウエハを加工機の所定部位に固定保持するこ とが必要となる。特に半導体ウエハ上に微細なパターン を描画し、多数の半導体素子を形成する集積回路の作成 においては、半導体ウエハを平坦な面に確実に保持させ る必要がある。従来、半導体ウエハを保持させる手段と しては、機械式、真空式 (流体の圧力差を利用したも の) および電気式のチャック装置が用いられている。こ れらの中で電気式のチャック装置、すなわち静電チャッ ク装置は平坦でない半導体ウエハであっても、密着性よ く固定できるとともに、取扱が簡単で真空中でも使用が 容易であるなどの利点を有している。ところで、半導体 ウエハの加工中にビーム粒子等が射出衝打された場合、 半導体ウエハ上には熱エネルギーが発生するが、この発 生熱エネルギーを容易に放出し得ない場合には、半導体 ウエハの局部的膨張および変形を引き起こす。したがっ て、加工中に発生した熱を金属基盤側に逃がし、半導体 ウエハ上の温度分布を均一にする必要がある。そのた め、これらの用途に使用される静電チャック装置には、 所定部位に確実に保持すると同時に熱伝導性の高いこと が機能として望まれる。

【0003】従来の静電チャック装置の一例、例えば、 特公平5-87177号に開示されている図2は従来の 静電チャック装置の一例の模式的断面図であって、金属

基盤1には恒温水等を通して温度調節するための温度調 節用空間6が設けられている。金属基盤1の上には静電 チャック機能を生じさせるための電極層3bと絶縁性フ ィルム4 a が接着剤層2を介して設けられ、絶縁性フィ ルム4 aには半導体ウエハ5が吸着される。該電極層3 bと金属基盤1との電気的短絡が生じないようにするた め、電極層と金属基盤との間に絶縁性フィルム4bが接 着剤層2を介して設けられている。また、図3は従来の 静電チャック装置の一例、例えば、特開平8-1485 49に開示されているものの模式的断面図である。金属 基盤1には上記のような温度調節用空間6が設けられて いる。金属基盤1の上には絶縁性の接着剤層2が形成さ れ、その上に金属の蒸着膜またはメッキ膜からなる電極 層3aが設けられ、その上に絶縁性フィルム4が設けら れてなり、これに半導体ウエハラが吸着される。上記の 静電チャック装置において、電極層3aの電極材料とし て、銅、アルミニウム、錫等を膜厚500オングストロ ーム~10μmに蒸着またはメッキしたものが、電極層 3bには、厚さ1/2oz(約18μm)、或いは1o z(約35μm)の銅箔が使用されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来の図2の静電チャ ック装置においては、半導体ウエハラ、電極層3b、金 属基盤1の相互間の絶縁を確保するため絶縁性フィルム 4 aおよび46を介在させ、半導体ウエハ5に対する温 度調整機能が悪かった。要するに半導体ウエハに対する 基盤の冷却機能が十分に働かないという問題があった。 また、図2の静電チャック装置については、その吸着面 において電極が存在する部分と存在しない部分との間 に、電極層の厚さに相当する程度の凹凸が生じ、凹部で は半導体ウエハとの間に空間が生じ熱の伝導が局部的に 悪くなる現象が生じた。この現象は冷却用ガスが用いら れない外周部で顕著となり、いわゆる絶縁幅の部分が浮 いた状態となって、真空中での熱伝導性が悪くなるとい う問題があった。また、図3のものは図2のものに比較 して、絶縁性フィルム、電極層および接着剤層の総厚が 薄くなり、熱伝導性は改善されている。しかしながら、 十分な絶縁性を確保するためには、接着剤層が少なくと も40~50µm以上必要であり、熱伝導性はまだ十分 なものではなかった。また、図2および図3の静電チャ ック装置を多数回使用すると、吸着面を有する絶縁性フ ィルムが疲労するため交換の必要性を生じるが、該金属 基盤より上部全体を貼り替えるために作業工程が多いこ とおよび熱硬化性接着剤を使用した場合は不溶化した接 着剤層洗浄工程の簡略化が望まれていた。

【 0 0 0 5 】したがって、本発明の目的は、静電チャック装置の熱伝導性を改善させると同時に、吸着面を有する絶縁性フィルムの交換性に優れた静電チャック装置およびその作製方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は金属基盤上に第 1の接着剤層、セラミックからなる絶縁板、第2の接着 剤層、金属の蒸着膜またはメッキ膜からなる電極層およ び絶縁性フィルムを順次積層してなることを特徴とする 静電チャック装置および絶縁性フィルムの一面に、金 の蒸着膜またはメッキ膜からなる電極層を構成し、該 を層の表面にフォトレジスト層を設け、バターン露 行い、現像し、エッチング処理を行う工程と、エッ グ処理された電極層面に第2の接着剤層を設けて積極 シートを作成する工程と、セラミックからなる絶縁 シートを作成する工程と、セラミックからなる絶縁を 第1の接着剤層を介して金属基盤に接着する工程とで ラミックからなる絶縁板と該接着体シートとを第2 の接 着剤層を介して接着する工程からなることを特徴とする 静電チャック装置の製造方法である。

【〇〇〇7】以下、木発明について詳細に説明する。図 1は本発明の静電チャック装置の一例の模式的断面図である。本発明の静電チャック装置は、金属基盤1の上に 絶縁性が優れた第1の接着剤層2aを形成し、その上に セラミックからなる絶縁板7が設けられ、その上に第2 の接着剤層2bを形成し、その上に金属の蒸着膜または メッキ膜からなる電極層3が、さらにその上に絶縁性フィルム4が設けられた構造を有している。電極層は絶縁 性フィルムの吸着面に分極電荷を発生するためのものである。なお、5は半導体ウエハ、6は温度調整用空間、 8は絶縁性フィルム・電極層+接着剤層からなる積層体 シートである。

【0008】電極層の蒸着やメッキに用いる金属としては、銅、アルミニウム、錫、ニッケル、クロム銀等の蒸着やメッキ等が容易にでき、かつウエットエッチング等によるパターン形成がしやすい材料であれば如何なる金属でもよく、安定した停電性と加工性が得られれば特に限定するものではない。この蒸着膜やメッキ膜の厚さは、300オングストローム〜10μmの範囲であればよい。アルミニウム等の反応性の高い材料の場合は、300オングストローム未満の膜厚であると、作業性が悪いと同時に安定した導電性を保持するのが難しいため、300オングストローム以上が好ましい。作業性等を考慮すると、蒸着膜やメッキ膜の厚さは500オングストローム〜5μmの範囲がさらに好ましい。

【0009】絶縁性フィルムに使用されるフィルムは ε、tanô、耐電圧等の電気特性および耐熱性等を考慮して、150℃以上の耐熱性を有する絶縁性フィルムが好ましく、特にボリイミドフィルムが好ましい。150℃以上の耐熱性を有する絶縁性フィルムとしては、150℃以上の耐熱性を有する絶縁性フィルムとしては、例えば、フッ素樹脂(フロロエチレンープロピレン共重合体等)、ポリエーテルサルフォン、ボリエーテルケトン、セルローストリアセテート、シリコーンゴム、ポリイミド等があげられる。ボリイミドフィルムとしては、例えば、カプトン(東レ・デュポン社製)、アピカル(鐘淵化学工業社製)、ユーピレックス(宇部興産社

製)等の商品名で上市されているものがあげられる。絶縁性フィルムの厚さは20~75μmの範囲が好ましい。熱伝導性、吸着力を考慮すると薄い方が好ましいが、機械的強度、耐電圧および耐久性(耐疲労性)を考慮すると40~60μmの範囲が特に好ましい。

【0010】本発明には、金属基盤上に第1の接着剤層を介してセラミックからなる絶縁板が積層される。該セラミックは、絶縁性および熱伝導性に優れ、耐溶剤性があることが必要で、具体的にはアルミナ、窒化アルミ、窒化珪素、炭化珪素、ジルコニア、ガラス等が好ましく、表面が平滑なものが使用される。また、該セラミックは被吸着面の熱を逃がすことおよび耐久性を考慮すると、厚さは0.5~8 mmの範囲が好ましく、更に好ましくは0.5~4 mmである。静電チャック装置は、半導体ウエハにHeガスを流して冷却することが一般的である。したがって、該セラミックからなる絶縁板にはHeガス孔を設けることが好ましい。

【0011】次に、これらの材料を金属基盤に接着するための接着層としては、絶縁性フィルム、電極層、セラミックからなる絶縁板および金属基盤の4者に対する接着力と電気特性および耐熱性に優れていることが必要であり、熱硬化性接着剤および熱可塑性接着剤が使用される。本発明に使用する接着剤を構成する樹脂の例としては、例えば、エポキシ系、ポリイミド系、変性ポリアミド系、ゴム系、ポリアミドイミド系、変性ポリエステル系等の接着剤が有効であり、それぞれ単独または混合物として用いることができる。

【0012】本発明の静電チャック装置に使用される絶縁性フィルムおよび接着剤層の熱伝導率は従来と同様な材料を使用するため変わらないが、絶縁性および熱伝導性に優れたセラミックからなる絶縁板を使用することで図3に開示された技術に比較して絶縁性フィルムとセラミックからなる絶縁板とを接着する第2の接着剤層および第1の接着剤層を薄くすることが可能になったことにより、吸着面に受ける熱を素早くセラミックからなる絶縁板に、また絶縁板から金属基盤に逃がすことができる。また、接着剤層が薄くなったため絶縁性フィルム交換作業時の接着剤層面洗浄工程が容易になり、交換作業性が改善された。

【0013】次に、本発明の静電チャック装置の作製方法について説明する。先ず、絶縁性フィルムの一面に蒸着法またはメッキ法により金属膜を形成し、その金属膜面にフォトレジスト層を形成する。フォトレジスト層を形成する。フォトレジストを塗布し、乾燥して形成してもよく、フォトレジストフィルム(ドライフィルム)を熱圧着により貼り合わせて形成してもよい。続いて、バターン露光、現像、エッチング、洗浄、レジスト剥離、乾燥を行い、所定の形状の電極層を形成する。これらの操作は、フォトレジストバターンを形成する公知の方法を使用して行えばよい。エッチング処理された電極層の金属面に、第

2の接着剤用塗液を塗布し、乾燥して第2の接着剤層を 形成し、積層体シートを作製する。該接着剤層は絶縁性 フィルムの被吸着面が受けた熱をセラミックからなる絶 縁板に逃がしやすくするため薄くすることが好ましい。 形成された積層体シートを必要に応じてセラミックから なる絶縁板の形状に合わせて打ち抜き加工を施して、静 電チャック装置用の積層体シートを作製する。

【0014】次に、前記セラミックからなる絶縁板を第 1の接着剤層を介して金属基盤に接着する。該接着剤層 は、前記したものが好ましく使用され、セラミックから なる絶縁板の熱を金属基盤に逃がしやすくするため薄く することが好ましい。次にセラミックからなる絶縁板と 該積層体シートとを第2の接着剤層を介して接着する。 熱硬化性接着剤を使用した場合は、必要に応じて適切な 加熱、半硬化させる処理および硬化処理を行う。上記の ようにして本発明の静電チャック装置を作製することが できる。吸着面の絶縁性フィルムが疲労した場合、疲労 した絶縁性フィルム、電極層および第2の接着剤層を剥 がし、新しい積層体シートを接着する。上記工程で、疲 労した絶縁性フィルムは簡便に交換できる。 【0015】以下、本発明を実施例に基づいてより詳細 に説明する。

【実施例】

実施例1

膜厚50μmのボリイミドフィルム(東レ・デュポン社製商品名:カプトン)からなる絶縁性フィルムにアルミニウムを800オングストロームの厚さに蒸着し、ネガ型感光フィルム(ヘキスト社製商品名:OZATECーT538)を貼り合わせて、露光一現像ーエッチングー洗浄一乾燥の工程を経て、所定の形状の電極層を形成した。なお、現像は炭酸ナトリウム1%水溶液をスプレー噴霧して行い、エッチングは塩化第1鉄と塩化第2鉄と塩酸水溶液をスプレー噴霧して行い、洗浄にはイオン交換水を用いた。次いで、該ポリイミドフィルムの電極表面に下記組成からなる接着剤を用いて、乾燥後の厚きが30μmになるよう塗布を行い、150℃で5分間乾燥して第2の接着剤層を形成し積層体シートを作成した。なお、部は重量部を示す。

 アクリロニトリループタジエンゴム
 100部

 (日本ゼオン社製商品名:ニッポール1001)
 50部

 (油化シェルエポキシ社製商品名:エピコートYL-979)
 50部

 クレゾール型フェノール樹脂
 50部

 (昭和高分子社製商品名:CKM2400)
 5部

 ジシアンジアミド(和光純薬社製)
 5部

 メチルエチルケトン
 500部

次に、アルミニウム金属基盤上に上記第1の接着剤層用 塗料を乾燥後の厚さが30μmになるよう塗布を行い、 150℃で5分間乾燥して第1の接着剤層を形成し、厚さ3mmのアルミナセラミック絶縁板(東芝セラミック ス社製商品名:AL-13)と貼り合わせた。この時、該金属基盤および該絶縁板は厚さ方向に貫通孔を開け、該金属基盤はその貫通孔内に導電性部材を通して、高を調整を展基盤間に電圧を印加できるようにした。次いで、該絶縁板と該積層体シートの第2の接着剤層面を貼り合わせた後、80℃~150℃のステップキュアー処理を5時間行って接着し、本発明による直径8インチの静電チャック面を有する静電チャック装置を作製した。 【0016】実施例2

実施例1で使用したアルミナセラミック絶縁板の代わりに厚さ2mmの窒化珪素セラミック絶縁板(東芝セラミックス社製商品名:TSN-03)を使用し、電極層に厚さ500オングストロームの銅メッキ膜を使用した以外は、実施例1と同様にして本発明による直径8インチの静電チャック面を有する静電チャック装置を作製した。

【0017】比較例1

実施例1で使用した厚さ50μmの絶縁性ポリイミドフィルムに実施例1で使用した接着剤を用いて、接着剤層

の乾燥後の厚さが10μmになるよう塗布を行い、15 O℃で5分間乾燥を行った後、厚さ23μmの網箔を貼 り合わせて80℃~150℃のステップキュアー処理を 行った。該ポリイミドフィルムの銅箔面に実施例1で使 用したネガ型感光フィルムを使用して実施例1と同様に して所定形状の電極を形成した。一方、他の前記ポリイ ミドフィルムの一面に、該接着剤用塗料を接着剤層の乾 **爆後の厚さが10μmになるよう塗布を行い、150℃** で5分間乾燥を行い接着剤層を形成した。該接着剤層と 前記電極を形成したポリイミドフィルムの電極面とを貼 り合わせた。次いで、この積層したポリイミドフィルム の一面に乾燥後の厚さが20μmになるよう接着剤用塗 料を塗布し、150℃で5分間乾燥を行った後、実施例 1で使用した金属基盤に貼り合わせ、80℃~150℃ のステップキュアー処理を行って直径8インチの静電チ ャック面を有し、図2に示す構造の静電チャック装置を 作製した。

【0018】比較例2

実施例1と同様にして一面にアルミニウム蒸着電極層を 形成したポリイミドフィルムの電極層面に、乾燥後の厚 さが20μmになるよう実施例1で使用した接着剤用塗 料を塗布し、150℃で5分間乾燥を行った。更に、該 接着剤層面に第2回目の塗布を行い膜厚40μmの接着 剤層を形成した。次に、実施例1で使用した金属基盤と該電極層を形成したボリイミドフィルムの接着剤層面を貼り合わせた後、80℃~150℃のステップキュアー処理を行って直径8インチの静電チャック面を有し、図3に示す構造の静電チャック装置を作製した。

【0019】前記実施例および比較例によって得られた 静電チャック装置を用い、半導体ウエハの表面温度を測 定し、その結果を表1に示した。

(測定方法) 半導体ウエハ上に温度測定プレートを貼り付け、下記エッチング条件にて1分間放電し、ウエハ中

心部、エッジ部、中間部の温度を測定した。なお、静電 吸着の印加電圧は2.0KVであった。

 (x_y+y) 条件) 高周波出力=1400(W)、チャンバー真空度=40(mT)、チャンバー内充填ガス: $CHF_5/CO=45/155(sccm)$ 、ウエハと静電チャック面を接触させた際の隙間に流すHeガス=10(Torr)、チャンバー内温度(上部/側面/底部)=60/60/20(C)

[0020]

【表1】

	中心部 (で)	中間部(じ)	エッジ部 (で)
実施例1	7 1 ~ 7 6	7 1 ~ 7 6	87~93
実施例2	71~76	71~76	87~93
比較例1	7 1 ~ 7 6	7 1 ~ 7 7	95~103
比較例2	71~76	71~76	90~96

【0021】表1の結果から明らかなように、本発明の静電チャック装置は半導体ウエハのエッジ部において面内温度が低く、放熱効果が大きいことが判る。本発明の静電チャック装置は、絶縁性が確保されるため比較例2よりも接着剤層を薄層化でき、放熱効果が大きいと同時に、絶縁性フィルム交換の際セラミック絶縁板上部の接着剤層洗浄が容易になるため、交換時の作業性が大幅に改善される。

[0022]

【発明の効果】本発明の静電チャック装置は、上記のようセラミック絶縁板に接着剤層を介して電極層および絶縁性フィルムが積層されてなるため、従来の静電チャック装置より薄層の接着剤層になる。したがって、熱伝導性を改善できると同時に、絶縁性フィルムが疲労した場合の交換作業性が大幅に改善される優れた効果を奏す

Z.

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の静電チャック装置の一例の断面図である。

【図2】従来の静電チャック装置の一例の断面図である。

【図3】従来の静電チャック装置の一例の断面図である。

【符号の簡単な説明】

1・・金属基盤、 2・・接着剤層、 2a・・第1の 接着剤層、2b・・第2の接着剤層、 3、3a、3b・・電極層、4、4a、4b・・絶縁性フィルム、 5・・半導体ウエハ、6・・温度調整用空間、 7・・絶縁板、 8・・積層体シート

【図3】

